

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## HG SEMICONDUCTOR LIMITED

### 宏光半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

- (1) 委任執行董事及副主席；
- (2) 委任執行董事及行政總裁；
- (3) 委任執行董事；
- (4) 行政總裁辭任；及
- (5) 董事辭任

本公佈乃由宏光半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

#### 委任執行董事及副主席

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐志宏博士(「徐博士」)獲委任為執行董事兼本公司副主席，自二零二三年二月六日起生效。

徐博士的履歷詳情載列如下：

#### 徐博士

徐博士，59歲，畢業於安徽財貿職業學院並獲頒經濟學學士，其後取得美國俄克拉荷馬城市大學工商管理學碩士學位及中國人民大學經濟學博士學位。

徐博士曾擔任招商永隆銀行有限公司(前稱為永隆銀行有限公司)董事總經理及中國工商銀行金融市場部總經理，具備豐富企業財務策劃經驗。於二零一九年十二月二日至二零二零年六月三日，徐博士擔任深圳證券交易所上市公司中潛股份有限公司(股份代號：300526)的董事及常務副總經理。自二零二零年九月一日至二零二一年八月三十一日，徐博士為聯

交所主板上市公司大唐西市絲路投資控股有限公司(「大唐西市絲路」，股份代號：620)執行董事兼行政總裁；而自二零二二年四月一日至二零二三年一月三十一日，徐博士為大唐西市絲路的執行董事、常務副主席及投資委員會主席。

徐博士曾獲得國務院特殊津貼專家之榮譽，並曾出任中國人民銀行金融產品委員會委員及中國城市金融學會理事。

根據本公司與徐博士訂立的服務協議，徐博士已獲委任為執行董事，初步任期自二零二三年二月六日起為期三年，可於當時任期屆滿後翌日自動重續(每次續期一年)，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據上述服務協議，徐博士的年度酬金待遇最高可達3.0百萬港元。徐博士的酬金乃參考現行市況、其職位與職責及本公司薪酬政策而釐定。有關酬金由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公佈日期，除上文所披露者外，徐博士(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

徐博士已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及並無其他事宜須促請本公司股東垂注。

## 委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，曹雨博士(「曹博士」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二三年二月六日起生效。

曹博士的履歷詳情載列如下：

## 曹博士

曹博士，43歲，於二零二一年加入本集團，為化合物半導體業務的核心專家，並擔任徐州金沙江半導體有限公司（「徐州金沙江」）以及FastPower Inc.（「FastPower」）的工程副總裁。彼於二零零二年畢業於中國江蘇省南京大學，獲頒物理學學士學位，並於二零零三年獲新加坡一麻省理工學院聯盟頒發微納米系統先進材料（Advanced Materials for Micro and Nano-Systems）碩士學位。在材料與工程研究院（新加坡）擔任研究員（research fellow）兩年後，彼入讀美國聖母大學，並於二零零八年獲頒電氣工程理學碩士學位，及後於二零一零年獲頒電氣工程博士學位及應用數學理學碩士學位。

畢業後，彼加入Kopin，成為該公司一名專注於MOCVD的III-V外延的資深科學家（staff scientist），其後隨著Kopin的III-V業務被收購，彼成為IQE的一名資深科學家（staff scientist）。於二零一四年，彼加入HRL實驗室任職研究科學家，專注於GaN基功率電子領域。於二零一七年至二零二一年期間，彼在Qorvo Inc.擔任高級項目群經理，負責管理多個專注於射頻電子的研究項目。於二零二一年十一月，彼加盟徐州金沙江及FastPower並擔任工程副總裁。曹博士在GaN、InN、AlN、GaAs、InP以及相關的三元和四元合金基電子以及光電器件的外延生長、表徵、器件設計及加工領域積逾20年半導體研究、開發及生產方面的成熟經驗，亦曾撰寫／合著四本書籍／書籍章節，申請12項專利，以及撰寫170多篇期刊及會議論文。作為電氣和電子工程師協會（「IEEE」）的高級會員，其亦曾擔任IEEE EDS化合物半導體器件與電路委員會（IEEE EDS Compound Semiconductor Devices & Circuits Committee）（由二零一九年至今）及IEEE高級會員申請評審小組（由二零二一年至今）的委員會成員、電化學學會（ECS）普通會員（Member at large、電子和光子學部（EPD）、電子和光子學部（EPD）執行委員會成員（由二零二一年至今）。彼為器件研究會議（Device Research Conference）（二零一六至二零一八年）、國際氮化物半導體論壇（International Workshop on Nitride Semiconductors）（二零一八年）、萊斯特—伊士曼會議（Lester Eastman Conference）（二零一八年、二零二零年、二零二一年）、IEEE電子器件技術與製造（二零二一年、二零二二年）、電化學學會（ECS）會議（二零一九年至二零二一年）的技術委員會成員及會議主席。彼亦於二零一九年擔任ECS Transactions的編輯，並在二零二零年擔任IEEE Transactions on Electron Devices的客座編輯。彼於二零一六年獲得IEEE George E. Smith Award獎，同時身為15份著名研究期刊的特邀審稿人。

根據本公司與曹博士簽訂的服務協議，曹博士已獲委任為執行董事，初步任期自二零二三年二月六日起為期三年，可於當時任期屆滿後翌日自動重續（每次續期一年），惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

曹博士亦為本公司間接附屬公司徐州金沙江以及本公司間接全資附屬公司FastPower的工程副總裁。曹博士有權自本集團收取年度酬金約3,200,000港元及酌情表現花紅。曹博士的酬

金乃參考現行市況、其職位與職責及本公司薪酬政策而釐定。有關酬金由薪酬委員會推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公佈日期，曹博士在本公司50,000股股份(相當於本公司已發行股份總數約0.0086%)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，曹博士(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

曹博士已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及並無其他事宜須促請本公司股東垂注。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳振博士(「陳博士」)獲委任為執行董事，自二零二三年二月六日起生效。

陳博士的履歷詳情載列如下：

### 陳博士

陳博士，50歲，於二零二一年加入本集團，為GaN半導體業務的核心專家，並擔任徐州金沙江的總經理。陳博士亦為FastPower的董事。彼畢業於中國四川省四川大學，分別獲頒半導體物理與器件學士學位及凝聚態物理學碩士學位。此後，彼於二零零二年獲位於中國北京的中國科學院半導體研究所頒授博士學位。

陳博士在GaN基光電工程設備領域擁有超過20年的研發、生產及管理經驗。彼掌握GaN電子器件及全波段固態發光器件的核心技術及8英寸矽基GaN外延生長的專有技術。彼曾擔任新加坡一麻省理工學院聯盟的研究員(Research Fellow)、南卡羅來納大學的博士後研究員(Postdoctoral Fellow)及加州大學聖巴巴拉分校的副項目科學家(Associate Project Scientist)，彼於其中亦曾與諾貝爾獎得獎者中村修二教授及美國工程院院士Umesh Mishra教授一同工作，工作內容有關加州大學開發的GaN高電子遷移率晶體管的性能，並研究GaN基紫外線至可見光LED的設計、生長及表徵以及在高功率、高頻率電子方面的應用。

彼於二零零九年至二零一二年在Bridgelux Inc.工作，該公司為LED照明技術及解決方案的領先開發商及製造商。彼於該公司發起對LED／矽(Si)的研發，並展示首個能投入運作的高功率矽基LED(LED-on-Si)，其光功率為藍寶石基LED(LED-onsapphire)最佳水平的50%。彼亦曾領導「倒裝芯片LED開發」項目中的外延(Epi)開發，並實現LED的插座效率(WPE)高於DA1000(此乃Cree最好的商用倒裝芯片LED，Cree為於照明級LED、LED照明以及無線及電源應用半導體解決方案方面領先市場的創新者)。陳博士亦曾於南昌晶能光電有限公司擔任核心管理及技術職務，並於其中參與矽襯底GaN的生產，該公司因此在二零一五年獲得中國國家科技創新獎一等獎。

陳博士曾於美利堅合眾國一家知名半導體公司擔任副總裁，彼於其中從事GaN基外置器件的研發及生產。彼亦曾撰寫／合著三篇書籍章節、50多篇同行評議學術論文及20篇會議論文集。彼曾申請國內外專利逾30項，並獲授逾10項專利。彼曾擔任逾十家國際期刊的審稿人。彼亦為IEEE光子學會的高級會員，並為IEEE電子器件協會的高級會員。彼目前的研究領域包括III-氮化物電子器件及波長從紅色到深紫外的光學器件。

根據本公司與陳博士訂立的服務協議，陳博士已獲委任為執行董事，初步任期自二零二三年二月六日起為期三年，可於當時任期屆滿後翌日自動重續(每次續期一年)，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

陳博士亦為本公司間接附屬公司徐州金沙江的總經理以及本公司間接全資附屬公司FastPower的董事。陳博士有權自本集團收取年度酬金約2,500,000港元及酌情表現花紅。陳博士的酬金乃參考現行市況、其職位與職責及本公司薪酬政策而釐定。有關酬金由薪酬委員會推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公佈日期，除上文所披露者外，陳博士(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。



陳博士已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及並無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐博士、曹博士及陳博士加入董事會。

## 行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，趙奕文先生（「趙先生」）由於本集團重新分配職責而辭任本公司行政總裁，自二零二三年二月六日起生效。趙先生仍繼續擔任本公司執行董事及主席。

趙先生已確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於出任本公司行政總裁期間所作出的貢獻。

## 董事辭任

董事會謹此宣佈，劉洋女士（「劉女士」）為投放更多時間處理個人事務而辭任執行董事、高級顧問及本集團所有其他職務，自二零二三年二月六日起生效。同時，王潔川先生（「王先生」）為投放更多時間處理個人事務而辭任非執行董事，自二零二三年二月六日起生效。

劉女士及王先生已確認，彼等與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝劉女士及王先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
宏光半導體有限公司  
主席兼執行董事  
趙奕文

香港，二零二三年二月六日

於本公佈日期，執行董事為趙奕文先生、徐志宏博士、曹雨博士、呂向榮先生、梁健鵬先生及陳振博士；非執行董事為王寧國博士；及獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲戟先生及李陽先生。

本公佈的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。